2軸 360°回転試料ホルダを用いた 3次元磁場トモグラフィー

Three-Dimensional Magnetic Field Tomography Using a Dual-Axis 360° Rotation Specimen Holder

常田るり子, 鹿島 秀夫, 原田 研, 岩根 智広, 池田 正樹, 菅原 昭, 高口 雅成 Ruriko Tsuneta, Hideo Kashima, Ken Harada, Tomohiro Iwane, Masaki Ikeda, Akira Sugawara and Masanari Koguchi

(株)日立製作所中央研究所

- 要旨3次元磁場トモグラフィーの精度向上のためにµピラー 用2軸360°回転試料ホルダを開発した.磁場の2成分は 2つの回転シリーズ像から各々再構成し,残り1成分は Maxwell方程式を用いて計算する.しかし薄膜用試料ホ ルダでは投影角度制限のある2成分しか再構成できない. 本試料ホルダでは投影角度制限の無い2成分が再構成で き,残り1成分の精度が大幅に向上する.このことを既 知の磁場分布を持つ試料で検証した.
- キーワード:磁場トモグラフィー,2軸360°回転試料ホルダ, µピラー試料,投影角度制限,電子線ホログラフィー

1. はじめに

磁性材料はモーター、インバータ、発電機、HDDなど、 社会インフラのキーデバイスに用いられる重要材料である. 機能発現機構解明と高性能化のためのナノ構造制御を進める ために、高分解能かつ高精度な磁性計測が求められる. 磁場 や磁性を高分解能で観察する技術の1つに、電子線トモグラ フィーを応用した磁場トモグラフィーがある. 磁場トモグラ フィーは 1990 年代から研究されており、1 軸回転シリーズ 像から試料外部の漏れ磁場を再構成する方法¹⁰ や、2 軸回転 シリーズ像から試料内外の磁場を再構成する方法^{2~4} が提 案されている. 2 軸回転シリーズ像を用いる方法では、磁場 の2 成分は 2 つの回転シリーズ像から各々再構成し、残り 1 成分は Maxwell 方程式を用いて計算する. ただし従来の薄 膜試料用試料ホルダでは投影角度制限の影響のある 2 成分し か再構成できない. そこで今回、投影角度範囲制限の無い 2 軸回転シリーズ像が得られる試料ホルダを新たに開発した.

本報では試料内外の磁場を2軸回転シリーズ磁場投影像か

〒 350-0395 埼玉県比企郡鳩山町赤沼 2520 番地 2013 年 9 月 3 日受付

ら再構成する方法を説明した後,開発した試料ホルダを用い て既知の磁場分布を再構成した結果を報告する.そして投影 角度範囲±60°の2軸回転シリーズ像から再構成した結果と 比較し,2軸360°回転シリーズ像撮影の効果を検証する.

2. 実験方法

2.1 2軸回転シリーズ像を用いた磁場トモグラフィー

ー般的な電子線トモグラフィーでは試料の電子線散乱能, すなわち組成情報を再構成する.組成情報はスカラー量であ るのに対し,磁場はベクトル場である点が大きな違いである. ここではスカラー量の投影とベクトル場の投影の違いを述べ た後,2軸回転シリーズ投影像を用いた磁場の再構成につい て説明する.

まず、装置に固定した座標系を XYZ, 試料に固定した座 標系を xyz とする. 電子線入射方向を Z 方向, 試料ホルダの 回転軸をY方向に設定する、スカラー量の場合、試料中の ある画素(Voxel)の強度 I(x,y,z) はどの方向から投影しても 同じ強度 I で投影される (図1(a)). 一方ベクトル場の場合、 投影方向によって投影強度が変化する.ここで、試料の v 方 向を装置のY方向と平行に設定する.回転軸と直交する B_v(x,y,z) と B_v(x,y,z) は、 試料を回転させると入射電子線とベ クトル成分とのなす角が変化し、回転角度θに応じた強度 $B_x \cdot \cos\theta - B_z \cdot \sin\theta$ で投影される (図 1 (c)). $B_v \ge B_r$ が混 在した投影強度しか得られないので, y 軸回りの回転シリー ズ像の逆投影で B, や B, を再構成することはできない. 一方, 回転軸と平行な B_v(x,y,z) は、試料を回転させても入射電子線 と直交するので同じ強度 B, で投影される (図1(b)). すな わち、v軸回りの回転シリーズ投影像の逆投影で再構成でき るのは B_vのみである.

そこで2軸回転機構を用い, y軸回りの回転シリーズ投影 像から B_yを, x軸回りの回転シリーズ投影像から B_xを再構 成し,残りの B_z は磁場の特性である Maxell 方程式 div**B** = 0 を用いて B_x と B_y から計算するという方法が提案されてい た³. しかし TEM/STEM で一般に用いられる薄膜試料を用 いた場合, B_x と B_y には投影角度制限によるアーティファク ト, すなわち div**B** = 0 とならない成分が混入するため, div**B** = 0 を用いて B_z を計算することが非常に困難であった. そこで我々は、次節で示す試料ホルダを開発した.

2.2 磁場トモグラフィー用試料ホルダ

ここでは以前に開発した1軸360°回転試料ホルダ⁶⁰を説 明した後,今回磁場トモグラフィー用に開発した2軸360°



図1 スカラー量の投影とベクトル場の投影



図3 試料ホルダの外観写真

回転試料ホルダを説明する.

投影角度制限によるアーティファクトの無い再構成像を得 るために、FIB で試料をµピラー状に加工することを考案し、 それを観察するための1軸360度回転試料ホルダを開発し た⁶⁾. その基本構成を図2(a) に示す. μピラー加工試料を 取り付けたニードルスタブを支持棒先端に装着し、支持棒を Y軸回りに360°回転させて投影像を撮影する. 今回の試料 ホルダ(図2(b))では、先端部にY軸と直交する軸回りに 回転する歯車を設け、この歯車にニードルスタブを装着する. ここでは簡単のために、点線で示したニードルスタブ長軸と μ ピラー y 軸のなす角を 45° にして説明する. 歯車を回転さ せてニードルスタブ長軸と支持棒の回転軸(Y軸)のなす角 を45°に設定すると、µピラー v軸が支持棒の回転軸と平行 になる. この状態で支持棒を回転させるとμピラーγ軸回り の回転シリーズ像が得られる. ニードルスタブ長軸と支持棒 の回転軸(Y軸)のなす角を-45°に設定すると、μピラーx 軸が支持棒の回転軸と平行になる.この状態で支持棒を回転 させるとµピラーx軸回りの回転シリーズ像が得られ、2軸 回転シリーズ像となる.図3に開発した試料ホルダの外観 写真を示す. 歯車にニードルスタブ差し込み冶具が装着され ており、これにニードルスタブを差し込んで使用する.

2.3 観察試料と撮影条件

今回, 既知の磁場分布を持つ試料として, Si 熱酸化ウエ ハ上に成膜された $Fe_{0.7}Co_{0.3}$ を FIB(日立ハイテクノロジーズ 製 FB-2100)にて直径~90 nmのµピラーに加工した試料 を用いた.加工試料の STEM 像を図4(a)に示す.FeCoの 下に FIB 加工にて非磁性層(W)を作成することで,図4(c) に示すような,棒磁石による磁場分布が形成される.棒磁石 上部の zx 断面では,磁場成分 B_x は上下対称な分布,磁場成 分 B_y は y 軸回りに回転対称な分布を示し,磁場成分 B_z は磁 場成分 B_x を y 軸回りに 90°回転させた分布となると想定さ れる.



 150 am
 (c) 磁場起因の位相像(d) 磁場投影像

 (a) 裏表の干渉像(b) 裏表の位相像

図5 表裏の干渉像から計算された磁場投影像

この試料の,図4(b)に示す回転軸①及び②まわりの回転 シリーズ像を撮影する。回転軸①と回転軸②はxy平面で互 いに直交する方向に設定した。歯車を回転させて試料の回転 軸①を支持棒の回転軸Yと平行に設定し,回転シリーズ像 ①を撮影する。本棒磁石では微細な磁場分布を形成しないこ とを事前に確認し、角度ステップは10°とし、0°から350° まで撮影した。回転シリーズ像①を撮影した後、歯車を回転 させて試料の回転軸②を支持棒の回転軸Yと平行に設定し、 回転シリーズ像②を撮影する。回転シリーズ像は、2段電子 線バイプリズム干渉光学系⁷⁷を搭載した300 kV 冷陰極電界 放出形透過電子顕微鏡(日立ハイテクノロジーズ製 H-9000FE)で回転シリーズ干渉像として撮影した。

3. 結果と考察

3.1 2 軸 360° 回転シリーズ像を用いた磁場再構成

ここでは2つの360°回転シリーズ像から磁場分布を再構成した結果を報告する.

まず、回転軸①と平行な磁場成分 B_1 を再構成する.回転 シリーズ干渉像をµピラーの頂点、すなわちµピラー上面 の左右中心が画像の中心になるようにアライメントした後、 各干渉像から各磁場投影像を計算した.図5に磁場投影像 の計算例を示す.まず、投影角度 θ の干渉像(図5(a))か らフーリエ変換法で位相像(図5(b))を計算した.計算さ れた位相像には電位による位相変化と磁場による位相変化が 混在しているので、投影角度 θ +180°の位相像を反転し、 投影角度 θ の位相像から引き算することで、電位による位相 成分を除き、磁場起因の位相像(図5(c))を作成した³. 磁場起因の位相像を回転軸①と直交する成分で微分すること で、回転軸①と平行な磁場成分 B₁の磁場投影像(図5(d)) が得られる²⁾. こうして計算された磁場成分 B₁の回転シリー ズ磁場投影像①を逆投影することで、磁場成分 B₁の3次元 分布を再構成した.

同じ手順で回転軸②と平行な磁場成分 B_2 の3次元分布を 再構成し,次式を用いて磁場成分 B_1 と磁場成分 B_2 から μ ピ ラー試料の x 軸方向の磁場成分 B_x と y 方向の磁場成分 B_y に 座標変換した.

$$\begin{bmatrix} B_{x} \\ B_{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{1} \\ B_{2} \end{bmatrix}$$
(1)

角度 α は x 軸と回転軸①のなす角を示す(図 4 (a) 参照). この計算を全ての xy 断面について行い,磁場成分 $B_x \ge B_y$ の3 次元分布を計算した.

次に、磁場成分 $B_x \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge$ 用いて磁場成分 $B_z \ge$ 計算した. 各 xy 断面において $B_x \ge x$ 微分して $dB_x/dx \ge B_y \ge y$ 微分して $dB_y/dy \ge B_x \ge x$ 微分して $dB_y/dx \ge B_y \ge y$ 微分して $dB_y/dy \ge B_z \ge x$ 電力 $dB_z/dx \ge x$ 之積算して $B_z \ge x$ 逃た. この計算は各 zx 断面について行った. 図 6 (a) は回転シリーズ像から計算された磁場成分 $B_x \ge B_y$ であり、図 6 (b) は磁場成分 $B_x \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ いて計算された磁場成分 $B_z \ge B_y$ から B_x は上下対称な、磁場成分 B_y は y 軸回りに回転対称な分布 になっており、棒磁石から発生する磁場分布 (図 4 (c) 参照) とほぼ一致していることが分かる. 磁場成分 $B_z \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ いて計算された磁場成分 $B_z \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ いて計算された磁場成分 $B_z \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ いて計算された磁場成分 $B_z \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ いて計算された磁場成分 $B_z \ge B_y$ から Maxwell 方程式 div $B = 0 \ge n$ の $E_z \le 2 \le n$

3.2 投影角度制限のある 2 軸回転シリーズ像を用いた磁 場再構成

ここでは薄膜試料を用いた時の一般的な投影角度範囲である±60°の2軸回転シリーズ像から再構成した結果と比較し, 2軸360°回転シリーズ像撮影の効果を検証する.

図6で使用した2軸360°回転シリーズ像から投影角度範 囲±60°の画像を抽出し,前節と同じ手順で再構成した. 図7にµビラー上部のzx断面(図6と同じ断面)の計算結 果を示す.回転シリーズ像から再構成される磁場成分B₁, B₂には,矢印で示す様な,投影角度制限による放射状のアー ティファクトが観察され,B₁とB₂を座標変換して計算され





図7 投影角度範囲±60°の2軸回転シリーズ像から計算され た磁場場成分の xz 断面表示



る B_x , B_y にも類似の放射状のアーティファクトが観察され る. 座標変換ではエラーの増幅はほとんど発生せず,投影角 度制限によるアーティファクトがそのまま反映されている. 次に, $B_x と B_y$ から Maxwell 方程式 div $\mathbf{B} = 0$ を用いて計算 された B_z をみると,想定される磁場分布,すなわち図 6 (b) の B_z とは異なる磁場分布になることが分かる.投影角度制 限によるアーティファクトが微分・積分で増幅されている. 投影角度制限によるアーティファクトを含む磁場成分 B_x と B_y から Maxwell 方程式 div $\mathbf{B} = 0$ を用いて B_z を計算するこ とは非常に困難であることが分かる.

図8に2軸360°回転シリーズ像から計算された磁場分布 と,投影角度範囲±60°の2軸回転シリーズ像から計算され た磁場分布のベクトル表示を示す.2軸360°回転シリーズ 像から計算された磁場分布では想定される磁場分布とほぼ同 じ分布になるが,投影角度範囲±60°の2軸回転シリーズ像 から計算された磁場分布では想定される磁場分布とは異なっ ていることが明確である.

4. まとめ

試料内外の磁場の再構成精度を向上させるためにµピラー 試料用2軸360°回転試料ホルダを開発した.本試料ホルダ を用いることで,投影角度制限の無い2成分が再構成でき, 残り1成分の精度が大幅に向上することを,既知の磁場分布 を持つ試料で実証した.なお,µピラー加工試料を用いるこ との欠点として,再構成領域が非常に狭くなる点があげられ る.µピラー直径の大きい試料も観察できるよう,加速電圧 1MV以上の超高圧透過電子顕微鏡による撮影が望まれる.

文 献

1) Shinada, H., Fukuhara, S., Seitou, S., Todokoro, H., Otomo, S.,

Takano, H. and Shiiki, K.: IEEE Trans. Magn., 28, 1017–1023 (1992)

- Lai, G., Hirayama, T., Fukuhara, A., Ishizuka, K., Tanji, T. and Tonomura, A.: *J. Appl. Phys.*, 75, 4593–4598 (1994)
- Phatak, C., Beleggia, M. and De Graef, M.: Ultramicroscopy, 108, 503–513 (2008)
- Phatak, C., Humphrey, E., De Graef, M. and Petford-Long, A.K.: Microsc Microanal, 15 (Suppl 2), 134–135 (2009)
- Kawasea, N., Katoa, M., Nishiokab, H. and Jinnai, H.: Ultramicroscopy, 107, 8–15 (2007)
- Koguchi, M., Kakibayashi, H., Tsuneta, R., Yamaoka, M., Niino, T., Tanaka, N., Kase, K. and Iwaki, M.: J. Electron. Microscopy, Vol.50, No.3, 235–241 (2001)
- Harada, K., Tonomura, A., Togawa, Y., Akashi, T. and Matsuda, T.: *Appl. Phys. Lett.*, 84, 3229–3231 (2004)